資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和４年６月６日

独立行政法人国立病院機構

千葉医療センター院長　森嶋　友一

◎調達機関番号　597　◎所在地番号　12

○第 03403 号（№03403）

1　調達内容

⑴　品目分類番号　71、27

⑵　導入計画物品及び数量　病院情報システム一式及び７年間の保守業務委託

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入期限　令和６年度第１・四半期

⑸　納入場所　独立行政法人国立病院機構千葉医療センター

⑹　調達に必要とされる基本的な要求要件　詳細は導入説明書による。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　令和４年７月８日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒260―8606 千葉県千葉市中央区椿森４－１－２　独立行政法人国立病院機構千葉医療センター企画課　佐藤　暢　電話043―251―5311

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　令和４年６月６日から令和４年７月８日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

5　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 71, 27

⑵　Nature and quantity of the product to be purchased : Hospital Information System 1 Set and system maintenance commission for 7 years

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement : Refer to the instructions for detail

⑸　Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M. July 8, 2022

⑹　Contact point for the notice : Mitsuru Satou, Director, Accounting Division, National Hospital Organization Chiba Medical Center, 4―1―2 Tsubakimori, Chuo-ku, Chiba City, Chiba-ken 260―8606, Japan. TEL 043―251―3511

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和４年６月６日

国立大学法人東北大学理事　植木　俊哉

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　04

○第５号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　24

⑵　導入計画物品及び数量　スピントロニクス材料成膜・デバイス形成システム　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　令和４年度11月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

A　革新的スピントロニクス材料成膜装置　１式

a　ＤＣ及びＲＦマグネトロンスパッタリング法により、300mmΦ基板上に薄膜の堆積を超高真空背圧下で３種類以上のガスを導入してできること。

b　プログラム制御により50枚以上の基板を連続して自動処理できること。

c　16元以上のカソードを備え、２元以上のカソードを同時に放電させることによる同時スパッタリング成膜ができること。

d　50～200℃の範囲及び350～450℃の範囲を含む任意の温度で基板を加熱しながら成膜する機構並びに80～200K（－193～－73℃）の範囲を含む任意の温度に基板冷却及び300～600℃の範囲を含む任意の温度で基板加熱できる機構を備えること。

e　400℃の熱処理後並びに０～30℃の測定温度範囲において、以下の特性を示す垂直磁化容易軸を有するCoFeBとMgOを含む磁気トンネル接合膜を基板上に90分以内で成膜できること。

⑴　自由層と固定層の反転磁場に50mT以上の差異があること。

⑵　トンネル磁気抵抗比が160％以上であること。

⑶　抵抗と接合面積の積（以下「ＲＡ」という。）が10Ω μ㎡以下であること。

⑷　上記ＲＡのばらつきが基板の半径130mmの範囲において±５％以下であること。

f　加工プロセスモジュールを含むモジュールを４つ以上増設できる拡張性を有すること。

B　スピントロニクスデバイス形成装置　１式

a　ＤＣマグネトロンスパッタリング法により、300mmΦの基板上に薄膜の堆積を超高真空背圧下で３種類以上のガスを導入してできること。

b　４元以上のカソードを備え、２元以上のカソードを同時に放電させることによる同時スパッタリング成膜ができること。

c　350～450℃の範囲を含む任意の温度に基板を加熱しながら成膜できること。

d　300mmΦの基板上の薄膜のエッチングを基板とエッチング源との角度を０～90度を含む任意の範囲に変えて、基板回転しながらエッチングできること。ただし、基板の法線方向とエッチング源の法線方向が一致する角度を０度と定義する。

e　エッチングのエンドポイントを検出する機構を備えること。

f　（A）革新的スピントロニクス材料成膜装置に接続し、プログラム制御によって300mmΦ基板を搬送し、成膜及びエッチングができること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　令和４年７月７日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒980―8577 仙台市青葉区片平２－１－１　東北大学財務部調達課調達第一係長　秋山　茂紘　電話022―217―4869

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　令和４年６月６日から令和４年７月７日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　令和４年６月13日10時00分

⑵　開催場所　オンライン開催とする。（詳細は、導入説明書による。）

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 24

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Spintronics Material Deposition and Device Fabrication System 1 Set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

A　Innovative spintronics materials deposition equipment

a　Thin film can be deposited by DC and RF magnetron sputtering on 300 mmΦ substrate using more than three type of gases under ultra-high vacuum background pressure.

b　More than 50 substrates can be sequentially processed by program control.

c　More than 16 cathodes are equipped and co-sputtering deposition using more than 2 cathodes is possible.

d　Temperature of substrate can be controlled at any temperature in the range including 50～200℃ and 350～450℃ during deposition, and can controlled at any temperature in the range including 80～200K（－193～－73℃）and 300～600℃ before deposition or after deposition.